

# Integra Technologies lance la première technologie RF GaN/SiC 100 V de l'industrie pour les applications de défense critiques

Integra, l'un des principaux fournisseurs de solutions innovantes RF et Microwave Power qui contribuent à créer un monde plus sûr et plus connecté, a présenté aujourd'hui la première technologie RF GaN/SiC 100 V du secteur ciblant un large éventail d'applications, notamment le radar, l'avionique, la guerre électronique, et les systèmes industriels, scientifiques et médicaux. Fonctionnant à 100 V, cette technologie brise les barrières de performance de puissance RF en atteignant 3,6 kilowatts (kW) de puissance de sortie dans un seul transistor GaN. Le GaN 100 V d'Integra donne aux concepteurs la possibilité d'augmenter considérablement les niveaux de puissance et les fonctionnalités des systèmes tout en simplifiant les architectures desdits système avec moins de circuits de combinaison de puissance par rapport à la technologie plus courante GaN 50 V/65 V. À terme, les clients bénéficient d'une empreinte système plus petite et d'un coût système inférieur.

Suja Ramnath, présidente-directrice générale d'Integra, a déclaré : « La technologie RF GaN 100 V d'Integra représente une étape importante sur le marché de la haute puissance. Cette technologie innovante supprime les barrières limitant les performances des systèmes d'aujourd'hui et permet de nouvelles architectures jusqu'alors impossibles. Nous sommes ravis de savoir que cette technologie de rupture va permettre à nos clients de proposer une nouvelle génération de solutions d'alimentation RF haute performance de plusieurs kilowatts tout en réduisant la durée de leurs cycles de conception et le coût de leurs produits. »

Le Dr Mahesh Kumar, architecte de systèmes radar pour l'aérospatiale et la défense et cadre technologique, a déclaré pour sa part : « La première technologie d'Integra RF GaN 100 V à atteindre le marché va redéfinir complètement ce qui est possible pour les systèmes RF haute puissance. » En fournissant approximativement deux fois plus de puissance qu'un transistor GaN 50 V dans un seul boîtier, la technologie va éliminer un nombre important de combineurs et de circuits électroniques associés, ce qui se traduira par un volume, un poids et un coût des systèmes inférieur et par une efficacité plus élevée de ces systèmes.

Le premier produit RF GaN 100 V d'Integra est l'IGN1011S3600, conçu spécifiquement pour les applications avioniques. L'IGN1011S3600 offre une puissance de sortie de 3,6 kW avec un gain de 19 dB et une efficacité de 70 %. L'IGN1011S3600, basé sur le RF GaN 100 V d'Integra, est une solution convaincante pour les programmes qui nécessitent des améliorations en termes de taille, de poids, de puissance et de coût (size, weight, power and cost, SWAP-C). L'IGN1011S3600 RF GaN/SiC 100 V est disponible à des fins d'échantillonnage pour les clients qualifiés.

Numéro de pièce	IGN1011S3600
Plage de fréquence	1030-1090 MHz
Puissance de sortie	3 600 W

Efficacité	70 %
Gain de grand signal	19 dB
Biais de drain	100 V

### **À PROPOS D'INTEGRA TECHNOLOGIES, INC.**

Fondée en 1997, Integra est un innovateur de premier plan en matière de solutions de palettes d'amplificateurs et de semi-conducteurs haute puissance RF et hyperfréquences pour les applications critiques, notamment les radars de pointe, la guerre électronique et les systèmes de communication avancés. Pour plus d'informations, visitez [www.integratech.com](http://www.integratech.com).

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.



Consultez la version source sur [businesswire.com](http://businesswire.com) :  
<https://www.businesswire.com/news/home/20210713006225/fr/>